有限要素法による電磁界シミュレーション入門 第2回「集中ポートの解析」



東京工業大学 環境·社会理工学院 平野 拓一

E-mail: hirano.t.aa@m.titech.ac.jp

December 21, 2017

波動方程式(EまたはHのみの式)



同様に、Eを消去してHの方程式を導くこともできる

Tokyo Institute of Technology

T. Hirano

励振問題と非励振問題



波源モデリング



T. Hirano

No. 5 電磁気学の知識からマクスウェルの方程式を導く

T. Hirano

マクスウェルの方程式



Philosophical Transactions of the Royal Society of London, vol.155, pp.459-512, 1865.

集中ポート(電圧と電流)



$$\begin{cases} \oint_{C} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_{S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_{C} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \iint_{S} \mathbf{i} \cdot d\mathbf{S} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{E} \mathbf{E} \ V_{0} = -\int_{\Gamma_{V}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \\ \mathbf{E} \mathbf{E} \ V_{0} = -\int_{\Gamma_{V}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \end{cases} \quad Z_{0} = V_{0} / I_{0} \\ \mathbf{E} \mathbf{E} \ \mathbf{E} \ \mathbf{I}_{0} = \oint_{C_{I}} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} \end{cases}$$

Tokyo Institute of Technology





HyをExで表す

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu\mathbf{H}$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\partial/\partial z & \partial/\partial y \\ \partial/\partial z & 0 & -\partial/\partial x \\ -\partial/\partial y & \partial/\partial x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$
$$= \hat{x} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) - \hat{y} \left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right) + \hat{z} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = -j\omega\mu H_y$$

Tokyo Institute of Technology

表面インピーダンス上の微分方程式

 $j\omega\mu E_x(0) - Z_s \frac{\partial E_x(0)}{\partial z} = 0$



Tokyo Institute of Technology

No. 11

集中ポートと表面インピーダンス

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{E_x}{H_y} \frac{\Delta x}{\Delta y} = j\omega\mu \frac{E_x}{\frac{\partial E_x}{\partial z}} \frac{\Delta x}{\Delta y}$$

$$I = J_s \Delta y$$

$$V = E_x \Delta x$$

$$Z = V / I$$

$$M_x = \frac{V}{\Delta x}$$

$$L = H_y \Delta y = \frac{1}{j\omega\mu} \frac{\partial E_x}{\partial z} \Delta y$$

$$Z = V / I$$

Tokyo Institute of Technology

T. Hirano

導体の表面インピーダンス近似(1)

εr1=1, εr2=4, σ2=0.001→10.0 (0.001,0.006,0.01,0.06,0.1,0.6,1.0,6.0,10.0) $θi=0^{\circ}$



これより、導電率が高い極限では2つの見方ができる。

1. 境界条件は、あくまで面電流など存在しない。 接線成分は連続であり、徐々に減衰してゆくという 見方(ミクロな見方)。

2. 少し離れたところからマクロにみると、表面電流が流れ、その電流の奥では電界磁界がゼロとなってしまう。つまり、磁界の接線成分は不連続になる。その差が面電流であると見る見方

ダイポールアンテナ

COMSOLによるダイポールアンテナの解析 No. 15



No. 16

GSGパッドの励振モデル

プローブ測定



GSGパッドの構造



GSGプローブの写真(コンタクト基板)

No. 19



GSGプローブの写真(ISS; 校正基板)



No. 20

GSGプローブの写真(パッド)







GSGプローブ先端の写真



解析における励振部のモデル化



電磁界解析モデル



E-Field Animation





Vector E-Field Animation



解析結果4ポートから実測2ポートへの変換^{No.27}



2 Lumped PortからGSG 1ポートへの変換 No. 28

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

プローブ部の導波路はシングルモードなので、次 の条件が成り立つ

 $a_1 = a_2 = a$



$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ a \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} b_1 = (S_{11} + S_{12})a \\ b_2 = (S_{21} + S_{22})a \end{cases}$$
単モードとパッド部の構造の対称性より、
$$S_{11} = S_{22} \qquad S_{12} = S_{21}$$

$$b_1 = b_2 (= b)$$
反射係数
$$\Gamma = \frac{b}{a} = S_{11} + S_{12} = S_{21} + S_{22}$$



<u>2 Lumped</u> Portから差動GSSG 1ポートへの変換²⁹

Tokyo Institute of Technology

T. Hirano



2.5 mm x 2.5 mm CMOS 0.18 um



5 mm x 5 mm CMOS 0.18 μm

Thruパターン

No. 32

 $420\;\mu m$



Thruパターン (Sパラメータ)







1020 µm

Lineパターン (Sパラメータ



クロストークによる結合量評価パターン

770um

Port1

クロストークによる結合量評価パターン(Sパラメー^Nタ)

Lumped Portの位置*d*_lおよび幅w依存性^{No. 38}

反射係数 S11

Tokyo Institute of Technology

T. Hirano

位置ずれおよび幅の影響は小さい

端部励振モデル1

端部励振モデル2

パッド下垂直励振モデル

SパラメータとZパラメータ

2端子

N端子

diag $(1/\sqrt{Z_i})$ diag $(\sqrt{Z_i}) = U$

Tokyo Institute of Technology

T. Hirano

Z行列⇒S行列

 $\begin{cases} \mathbf{a} = \frac{\operatorname{diag}(1/\sqrt{Z_i})\mathbf{V} + \operatorname{diag}(\sqrt{Z_i})\mathbf{I}}{2} \\ \mathbf{b} = \frac{\operatorname{diag}(1/\sqrt{Z_i})\mathbf{V} - \operatorname{diag}(\sqrt{Z_i})\mathbf{I}}{2} \\ \begin{cases} \mathbf{a} = \frac{\operatorname{diag}(1/\sqrt{Z_i})Z + \operatorname{diag}(\sqrt{Z_i})U}{2} \mathbf{I} & \longrightarrow \mathbf{I} = 2\left[\operatorname{diag}(1/\sqrt{Z_i})Z + \operatorname{diag}(\sqrt{Z_i})U\right]^{-1} \mathbf{a} \\ \\ \mathbf{b} = \frac{\operatorname{diag}(1/\sqrt{Z_i})Z - \operatorname{diag}(\sqrt{Z_i})U}{2} \mathbf{I} & \longleftarrow \mathbf{I} = 2\left[\operatorname{diag}(1/\sqrt{Z_i})Z + \operatorname{diag}(\sqrt{Z_i})U\right]^{-1} \mathbf{a} \end{cases}$

$$\mathbf{b} = \left[\operatorname{diag}(1/\sqrt{Z_i})Z - \operatorname{diag}(\sqrt{Z_i})U \right] \operatorname{diag}(1/\sqrt{Z_i})Z + \operatorname{diag}(\sqrt{Z_i})U \right]^{-1} \mathbf{a}$$

$$S$$

S行列⇒Z行列

$[S] = ([Z] - [D])([Z| + |D|)^{-1})$ [S]([Z]+[D]) = ([Z]-[D])(|S| - |U|)[Z] = -([S] + [U])[D] $[Z] = -([S] - [U])^{-1}([S] + [U])[D]$

概説

- ■ICをパッケージに実装した際の特性変化をシミュレーションするときなどに使われる。
- ■チップは集中定数素子として動作することを想定する。
 ■チップのパッドからボンディングワイヤ等で外部端子に出すが、その際の特性変化を電磁界シミュレーションする。

T. Hirano

GSM Solver

GSM Solver

Generalized Scattering Matrix (GSM) Solver is a free software to solve connected scattering matrix network. User can specify arbitrarilyconnected scattering matrix network by using two input files. One input file specifies scattering matrices of each block, another one describes connection network, excitation and matched-load terminal condition.

Copyright (c) 2007 Takuichi Hirano (Tokyo Institute of Technology)

[Keywords]

Generalized Scattering Matrix (GSM), Scattering Matrix (S-Matrix), Microwave Circuit, Antenna, High Frequency, Electromagnetic Wave, Distributed Constant Circuit, Connection, Mode, Transmission Line, Waveguide, Microstrip Line, Coaxial Cable, Simulator

1. Introduction

1.1 Overview

Generalized Scattering Matrix (GSM) Solver is a free software to solve connected scattering matrix network. User can specify arbitrarily-connected scattering matrix network by using two input files. One input file specifies scattering matrices of each block, another one describes connection network, excitation and matched-load terminal condition.

http://www.takuichi.net/free_software/gsm_solver/

No. 54

COMSOLによるMSL解析の実例

1: モデル化 (Port1)

1: モデル化 (Port2)

🏴 | 🗅 📂 🔒 🔣 🕨 ち さ 盲 🛍 🖷 👜 📓 🚳 🔩 📲 msl_pec_lump_port2.mph - COMSOL Multiphysics Х ? File 🔻 Home Definitions Results Geometry Materials Physics Mesh Study Developer Model Builder Settings Properties Graphics ★ # ← → ↑ ↓ ॼ ▾ ☶ ☷ Lumped Port -Ē Label: Lumped Port 2 Global Definitions Boundary Selection Pi Parameters Materials Manual Selection: • ▲ 1 コンポーネント 1 (comp 1) ч. ± 1 Definitions ON 🔲 14 0.02 ▲ × ジオメトリ1 _ m ブロック1 (blk1) ĥ 8 Active ブロック 2 (blk5) 0 ÷ 10ック 4 (blk4) 一体化モデルで完成 /) Materials -0.02 🔺 🚟 電磁波 (周波数領域) *(en* Override and Contribution 🄚 波動方程式 (電場) 1 🔚 電気壁 (PEC) 1 Equation Ъ 初期値 1 1.5 Lumped Port Properties 📄 電気壁 (PEC) 2 📄 散乱境界条件 1 1 Lumped port name: Eumped Port 1 📄 Lumped Port 2 2 0.5 1 בלילא 🔬 Type of lumped port: 0 ▷ ~ 29571 Uniform • A kesults Data Sets 0.01 Terminal type: 🛛 🎝 Views Cable 0 • B 8-85 Berived Values Tables Wave excitation at this port: -0.01 m ▷ 🎬 電場 (emw) Off • 🖻 隨 Export 🔣 Reports Settings Characteristic impedance: Messages Progress Log Table ▼ # X Z_{ref} 50[ohm] Ω COMSOL Multiphysics 5.3.0.260 Opened file: G:¥Home¥hira2¥public_html¥em_analysis¥canonical¥msl¥msl_pec_lump_port2.mph 758 MB | 927 MB

No. 57

1: モデル化 (散乱境界条件)

1: モデル化 (電気壁1)

1: モデル化 (電気壁2)

No. 60

2: 解析条件 (周波数領域)

T. Hirano